

Silicijevе planarne signalne diode

Silicon planar signal diodes

Tip/Type		U_{BR}	I_{FAV}	U_F pri/at I_F		I_R		C	t_r		Sl./ Fig
		$100\mu A$	$\theta_{amb}=25^{\circ}C$	$\theta_{amb}=25^{\circ}C$		pri/at $25^{\circ}C$	pri/at U_R	pri/at 1 MHz $U_R=OV$			
		(V)	(mA)	(V)	(mA)	(nA)	(V)	(pF)	(ns)		
BA 511	1N4148	100	150	1.0	10	25	20	4	4 ¹	8 ²	1
BA 513	1N4448	100	150	1.0	100	25	20	4	4 ¹	8 ²	
BA 517	1N4150	70 1 μA	200	1.0	200	100	50	2,5	4 ²	4 ²	
BA 518	1N4151	75 5 μA	150	1.0	50	50	50	2	2 ¹	4 ²	
BA 519	1N4152	40 5 μA	150	0.88	20	50	30	2	2 ¹	4 ²	
BA 520	1N4153	75 5 μA	150	0.88	20	50	50	2	2 ¹	4 ²	
BA 521	1N4154	35 5 μA	150	1.0	30	100	25	4	2 ¹	4 ²	
BA 523	1N4444	70 5 μA	200	1.0	100	50	50	2	7 ²	7 ²	
BA 531	1N4727	30 5 μA	150	0.85	10	100	20	4	4 ²	4 ²	
BA 533	1N4864	125	200	1.1	100	100	80	1.3	4 ¹	8 ²	
BA 543	BAY 17	15	200	1.0	100	100	12	1.5	50 ³	50 ²	
BA 544	BAV 18	60	200	1.0	100	100	50	1.5	50 ³	50 ²	
BA 545	BAV 19	120	200	1.0	100	100	100	1.5	50 ³	50 ²	
BA 546	BAY 20	180	200	1.0	100	100	150	1.5	50 ³	50 ²	
BA 547	BAY 80	150	200	1.0	100	100	120	6	50 ³	50 ²	

* pri/at 100° C

¹ $I_F = 10$ mA, $U_R = 6$ V, $I_{RR} = 1$ mA, $R_L = 100 \Omega$ ² $I_F = 10$ mA, $I_R = 10$ mA, $I_{RR} = 1$ mA³ $I_F = 30$ mA, $I_R = 30$ mA, $I_{RR} = 3$ mA, $R_L = 100 \Omega$

Silicijevе preklonpne diode

Silicon switching diodes

Tip/Type	U_{RRM}	I_F	θ_{sig}	U_F pri/at I_F		C pri/at $1 MHz$ $U_R = 3V$	r_f pri/at $f = 100 MHz$ $I_F = 10 mA$	Sl./Fig.
	(V)	(mA)	(°C)	(V)	(mA)	(pF)	(Ω)	
BA 244 A	20	100	-50 do/to +100	<1	100	<1,8	0,5	1
BA 182 A	20	100	-40 do/to +100	<1,2	100	<1,25	0,7	2

Dioda s spremenljivo kapacitivnostjo

Capacitance diodes

Tip/Type	U_{RRM}	C_r pri/at U_R (1 MHz)		$\frac{C_r(U_{R1})}{C_r(U_{R2})}$	U_{R1}	U_{R2}	r_g	Sl./Fig.
	(V)	(pF)	(V)		(V)	(V)	(Ω)	
BB 105 A	30	2,3 do/to 2,8	25	4 do/to 5	3	25	0,8	2
BB 105 B		2 do/to 2,3	25	4,5 do/to 6	3	25	0,8	
BB 105 G		1,8 do/to 2,8	25	4 do/to 6	3	25	1,2	

